

با توجه به رابطه ای که برای C به دست آوردیم نتیجه می گیریم که با افزایش مساحت صفحه ها (د) یا کاهش فاصله بین صفحه ها (ه) یا تغییر الکترونیک با ϵ نیز می توان ظرفیت خازن را افزایش داد.

با استفاده از رابطه $C = \frac{Q}{V}$ که در بالا آمده است می توانیم ثابت دی الکتریک ϵ_r را اندازه گیری کنیم. به این صورت که با داشتن ظرفیت یک خازن موازی - صفحه که داخل آن مادی الکتریک مورد نظر پر شده است و ظرفیت C_0 آن در حالتی که بین صفحه ها هواست می توان ϵ_r را به صورت مقابل به دست آورد: $\epsilon_r = \frac{C}{C_0}$

* ظرفیت معادل خازن های موازی :
مطابق شکل سه خازن به طور موازی به یکدیگر متصل شده اند با یکی دهانه متوجه می شویم که در این شکل به جای داشتن یک سطح هادی در واقع بین از دو قطه هادی وجود دارد (سه صفحه سگلی) دهنده موخانی سگلی یک هادی و سه صفحه زیرین سگلی هادی دیگر را می دهد (برای محاسبه ظرفیت این دو هادی جدید با هم می یابیم) به موجب $C = \frac{Q}{\Delta V}$ ، بار کل Q واقع بر یک هادی را به اختلاف پتانسیل آنها تقسیم نمود چون بار $(q_1 - q_1)$ ، $(q_2 - q_2)$ و $(q_3 - q_3)$ به ترتیب در صفحات هادی C_1 و C_2 و C_3 ذخیره شده است ظرفیت این دو هادی جدید برابر :

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \quad \text{و} \quad Q = q_1 + q_2 + q_3$$

